第2回 コンパクト ERL サイエンスワークショップ

# cERLによる強レーザー場中の 分子挙動の研究



# 光電離の立体ダイナミクスの解明



- 4 重コインシデンス [e<sup>-</sup> + frag<sup>+</sup><sub>1</sub> + frag<sup>+</sup><sub>2</sub> + frag<sup>+</sup><sub>3</sub>]:
  信号強度非常に弱い
- レーザーによる配向/援用
- レーザーポンプ-ERL プローブ
  - 非 Franck-Condon 領域・振動波束の生成

## 空間配向分子の光電離

- 夢:分子をある配向で静止
   基板に固定して観測 ← 満足できない
   量子力学的純粋状態の観測ではない
- "選択"または"制御","制御 & 選択"
   選択 ⇐ 内殻過程の特徴 + コインシデンス法
- 分子の空間配向の制御・選択 + ERL
  DC 電場・AC 電場による制御・選択
  レーザー場による制御
  - ERL の短パルス性 (≈ 0.1 ps)

### 強レーザー場中の原子・分子・クラスター

- 新奇な対象: 強レーザー場中にある原子分子
- 中程度のパワー密度: 10<sup>11</sup>-10<sup>12</sup> W cm<sup>-2</sup>
  - 分子の配列あるいは変形
  - Coulomb 爆発が起こる領域よりも低いパワー密度



K. Yamanouchi, Science 295, 1659 (2002).

## レーザー場による分子配向

- 3 つのタイプに分類できる
  - H. Stapelfeldt and T. Seideman, *Rev. Mod. Phys.* **75**, 543 (2003).
  - 断熱的配向  $\tau \gg \tau_{rot}$
  - 非断熱的配向  $\tau \ll \tau_{rot}$
  - 急激遮断  $\tau_{on} > \tau_{rot}, \tau_{off} \ll \tau_{rot}$
- 断熱的配向
  - –時間同期はすでに実現できている
    –完全な自由場での実験にはならない
- 非断熱的配向

- プローブも短パルスである必要性



## 電子線回折による高速現象の解明の例



## 気相分子の光電子回折パターン測定

- 電子線回折よりも局所的な情報が得られる可能性
- 一般的な光電子回折パターン
  - 前方散乱方向への強度の集中
  - 解析の手法が確立されている?
- 低速光電子回折 (KE ≤ 250 eV)
  - 後方散乱方向での強度の大きな変動 ⇒ EXAFS 変動
  - 化学シフトの大きさの違いによるサイト選択性
  - 振動準位分離

# 第一歩:レーザー配列した分子の アンジュレータ光 によるプローブ



## 強レーザー場中 CS<sub>2</sub> 分子

- 強レーザー場中での分子
  - 分子の断熱的配向
  - 分子のドレスト状態における構造変形
  - 参考文献
    - H. Stapelfeldt and T. Seideman, Rev. Mod. Phys. 75, 543 (2003).
    - 星名賢之助ら, J. Chem. Phys. 118, 6211 (2003).

#### - これまでのところ有効なデータは得られていない

### SRとNd:YAGレーザーの組合せ

#### 特性

- UR @ BL2C PF
  - 250~1400 eV
  - 1.6 MHz (シングルバンチ時)
  - ~ 10<sup>10</sup> photons/s/0.02%BW
    (~ 5 × 10<sup>3</sup> ph/pulse/0.02%BW)
  - パルス幅 100 ps のオーダー
- パルス Nd:YAG レーザー
  - 1064 nm (fundamental)
  - 1 J/p × 30 Hz (保有機器)
  - パルス幅 7-10 ns

レーザーとの比較

- 放射光の利点:
  - <u>高い波長掃引性</u>
  - 高いエネルギー
    - 真空紫外領域以上
    - 荷電粒子生成
- 放射光の欠点
  - <u>光子数/パルスが少ない</u>
  - <u>非常に低いコヒーレント性</u>
  - 光の操作はすべて真空中
  - (他光源との同期は困難)

## 強レーザー場中分子の分光計測



- 寺本高啓ら, AIP Conf. Proc. 879, 1805 (2007). "SRI2006"
- ナノ秒パルスNd:YAGレーザー: 0.4~0.5 TW/cm<sup>2</sup>
  - 1064 nm, パルス幅 ~8 ns, 0.8~1 J/pulse × 30 Hz
  - ビーム広がり < 0.5 mrad / 2 (エクスパンダー), f = 750 mm  $\rightarrow$  125  $\mu$ m
- PF BL2C
  - 0次光(アンジュレータから光を分光せずに使用)
  - 四象限スリットにてスポットサイズを限定





#### 有効なデータが得られていない要因

- 重ね合わせの精度が不充分であった
  現在は1点での位置合わせは改善されてきている
- レーザーの集光サイズよりも放射光のほうが大きい
   観測されているイベントは強レーザー場の外からの寄与
  - 四象限スリットがレーザーにより破損
- CS<sub>2</sub>分子由来のイベントが少ない
  - 50000 cps 以上は処理し切れていない?
  - 冷却により分圧が低くなりすぎた
  - 0次光のすそのエネルギー成分は不明確

# 現状より高度な実験に向けて

- スポットサイズの適合性
  - 現状では
    - SR:  $\geq 100 \ \mu m$
    - レーザー: 焦点距離に依存
  - SR スポットをより絞る必要
- パルス幅の適合性
  - 強いピークパワーのレーザー
    - Nd:YAG: 10 ns
    - Ti:Sapphire: 1ps–10fs
      - パルス幅の伸長が必要?
  - SR
    - 現世代リング~100 ps
    - 次世代技術が必要



## 60-200 MeV ERL における CSR-ICS

TABLE I: Optical cavity scheme in the Compact ERL : Horizontal acceptance angle are 50 mrad for  $\lambda = 190 \ \mu m$  and 110 mrad for  $\lambda = 1900 \ \mu m$  for mode matching. Bandwidth of the on-axis X-ray is considered to be  $\Delta \lambda_X / \lambda_X \sim \Delta \lambda / \lambda \sim 0.1$  (10%). Pulse duration of the X-ray is same as  $\sigma_z/c$ .

Electron	Charge	$\sigma_z/c$	Spot size	CSR	Κ	X-ray	$N_X$	$N_X$
energy $[MeV]$	[nC]	[ps]	$[\mathrm{mm}  imes \mathrm{mm}]$	energy [mJ]		energy $[keV]$	[phs./pulse]	[phs./s]
60	0.077	0.1	0.3 imes 0.3	0.14	0.013	0.4	$1  imes 10^4$	$2 \times 10^{13}$
60	0.5	1	$3 \times 3$	0.6	0.009	0.04	$4 \times 10^4$	$0.7 imes10^{13}$
200	0.2	0.1	0.3 imes 0.3	1.0	0.034	4	$2  imes 10^5$	$1  imes 10^{14}$
200	1	1	$3 \times 3$	2.5	0.017	0.4	$3 imes 10^5$	$3  imes 10^{13}$

- Number of photons of X-ray (b.w.10%)
  - Number of photons per pulse : ~ 10<sup>4-5</sup> phs/pulse.
  - Flux : ~ 10<sup>13-14</sup> phs/s.
- Energy range of X-ray
  - From **0.04 to 4 keV**.
  - 10 keV X-ray is possible at electron energy of 200 MeV and bunch length 50 fs, which is accomplished in tracking simulation.
- Pulse duration of X-ray is **100 fs 1 ps**.
- Electron transverse beam size is much smaller than the focus size of focused CSR.

Ref. 島田美帆 博士 発表資料より

## 測定スキーム1 強レーザー場中にある直線分子の変形

- 内殻光電子回折パターン ⇒ 構造変形
- 断熱的配向 + 非断熱結合



## 測定スキーム 2 非断熱的レーザー配列・配向させた分子からの 光電子角度分布測定

- 非共鳴過程による分子配列
  - 非断熱過程 (sub ps)
    - 高強度フェムト秒レーザー
  - 断熱-非断熱中間領域
    - 高強度フェムト秒レーザー + パルス伸長
- "着衣"分子についての新しい情報が得られる可能性?
- 非解離性電離過程についての MFPAD 測定に適用?



#### まとめ

- 時間コヒーレント性なしでは本質的に異なる研究は困難
- ・ 強レーザー場中原子分子の挙動・電子的構造
  - 試みの実験からは有効なデータが得られてない
  - ナノ秒パルスレーザー場 + 100 ps SR プローブ
- CSR-ICS による軟 X 線は利用可能
  - 10%BW でも pulse あたりはアンジュレータ光と同程度
  - 光学レーザーのより早い繰返しが必要
  - 新しい情報を得るためには異なる測定スキーム
- ERL実機で時間分解光電子回折実験を展開

#### 謝辞:これまでの実験・計算

- 実験
  - 柳下明教授
  - 山内薫教授
  - 寺本高啓博士
- 実験アドバイス

   酒井広文 准教授
   峰本紳一郎 博士
  - 岩崎純史博士

- 散乱理論計算
  - 藤川高志 教授
  - 篠塚寛志博士
  - 風間美里氏
- 研究助成

   松尾学術振興財団
  - 科研費
  - 特定領域研究 "強光子場分子制御"

• PFスタッフの皆様

この他多くの方々の協力により 研究を進めることができました ありがとうございました